

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和4年6月21日(2022.6.21)

【公開番号】特開2021-118916(P2021-118916A)

【公開日】令和3年8月12日(2021.8.12)

【年通号数】公開・登録公報2021-037

【出願番号】特願2021-78622(P2021-78622)

【国際特許分類】

A 6 1 B 5/055(2006.01)

G 0 1 N 24/10(2006.01)

G 0 1 R 33/381(2006.01)

G 0 1 N 24/00(2006.01)

10

【F I】

A 6 1 B 5/055 3 3 0

A 6 1 B 5/055 3 3 1

A 6 1 B 5/055 3 4 0

A 6 1 B 5/055 3 3 2

A 6 1 B 5/055 4 0 0

G 0 1 N 24/10 5 1 0 Y

G 0 1 R 33/381

G 0 1 N 24/00 6 0 0 A

20

【手続補正書】

【提出日】令和4年6月13日(2022.6.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願の相互参照

本出願は、2019年7月25日提出の特願2019-137259の分割出願であり、特願2019-137259は、2018年5月30日提出の特願2018-104096の分割出願であり、特願2018-104096は、特願2015-557977の分割出願であり、特願2015-557977は、2015年8月13日付の国内書面の提出により国内移行したものであり、2013年2月14日に出願された、国際出願第PCT/US2013/026006号に対応する日本出願である。前記国際出願は、2011年8月10日に出願された特許文献1の利益を主張している、2012年8月10日に出願された特許文献2に関連する。

40

【0002】

連邦出資の研究及び開発に関する声明

本開示は連邦支援の研究及び開発の主題でなかった。

【0003】

本開示は、電流の印加を介した磁界パターンの確立に関し；より詳細には、本開示は、磁気共鳴イメージング(MRI)スキャナの文脈における、ならびに、対象からの情報の導出のために正確な磁界パターンの上記確立を同じく必要とする、核磁気共鳴スペクトロスコピー、電子常磁性共鳴イメージング、及び電子常磁性共鳴スペクトロスコピーなどの、

50

他のシステムの文脈における電流の印加を介した磁界パターンの確立に関する。

【背景技術】

【0004】

磁気共鳴イメージング(MRI)スキャナ及び他の同様のデバイスは、対象内に本質的に存在する磁気モーメントの配向を正確に操作するように磁界を確立する。これらの磁界によって正確に配向される磁気モーメントがスキャナ内に電気信号を生成し、次にこれらの信号が使用されて、対象の内部組成の詳細な画像が構築される。

【0005】

イメージングの所与の時点において、イメージングのために特に設計されたスキャナのボリウム内で、MRIスキャナ内に確立されるトータル磁界は、通常、スキャナによって、その設計されたイメージングボリウム内で、発生された2つ以上の極めて異なる磁界パターンの合計である。これらのパターンは、それらの正味の効果が、特定の時点において所望される磁気モーメント配向をもたらすように、慎重に設計され、タイミングをとられなければならない。MR画像取得にとって重要であると見なされる磁界パターンは、極めて強く均一である B_0 界；無線周波数において振動する B_1 界；ならびに、各々の大きさがx方向、y方向、及びz方向においてそれぞれほぼ線形的に変化するx傾斜界、y傾斜界、及びz傾斜界である。 B_0 界の均一性の改善のために、シミング磁界も頻繁に使用される。

10

【0006】

(x傾斜界、y傾斜界、及びz傾斜界をそれぞれ生成する同じ複数の構造によって生成され得る)線形シミング磁界を除いて、上記の磁界パターンの各々は、通常、その磁界パターンに専用のスキャナ内の一つ又は二つの構造によって生成され、そのような各構造は、電流の構成であるか又は永久磁石の構成である。抵抗性MRIスキャナの場合、非超伝導電氣的構成が、通常、所望の磁界パターンのすべての生成に関わる。

20

【0007】

MRイメージングは、病気診断に大きい成功を伴って適用されてきた。しかしながら、癌検査を含む、病気検査へのMRIの拡張は、残念ながら比較的限定されている。検査のためのMRIの使用を著しく限定する2つの要因は、MRIスキャナ構築に一般に関連する比較的高いコスト、及びMRIスキャナ内に見られる典型的に小さい患者空間に通常関連する不快感である。

30

【0008】

MRIスキャナをより安価で広々としたものにし、したがって、特に病気検査のほうに指向したスキャナを開発するための1つの手法は、MRIにおいて使用される複数の磁界パターンを、それらのそれぞれの電流の合計を搬送する構成を用いて同時に生成することであろう。 B_0 界、傾斜界、及びシミング界のすべてのベクトルは主に単一の方向、慣例によればz方向に配向されることになるので、原理上はこれらの界の電流を合計することが考えられる。

【0009】

しかしながら、合計された電流構成とともに複数の傾斜界及び/又はシミング界を発生することに極めて成功しているように思われる方法は開発されたが、特に B_0 界を、合計電流構成を通じて傾斜界及び/又はシミング界と合成するための実際的な手段はまだ導入されていない。例えば、ゲープハルトらの特許文献3の図14は、異なるMRI磁界パターンを同時に確立することができ、ループの平面に直角に配向された規則正しく離間したラインセグメントによって接続される一連の並列同軸ループからなる電氣的構成を示している。 B_0 界に必要な電流は、ループ巻線が使用されないときは数万アンペア程度であるので、仮定的 B_0 界に寄与するこの構造中の各ループは、極めて大きい電流を供給することが可能な電圧源を有しなければならないであろう。したがって、十分均一な B_0 界のために最低4つのループを仮定すると、その構造がそれ以外の磁界パターンの中でも B_0 界を発生するためには、極めて大きい電流のための4つの電圧源が必要とされよう。

40

【0010】

50

ワトキンズらの特許文献4の図1は、個々のループが、独立した電圧源をもつ別個のループセグメント、すなわち別個のアークと置換された電氣的構成を開示している。各セグメント化されたループにおける、及び全体としての構造における電流パターンは、異なるMRI磁界パターンに関連付けられた電流パターンの合計を表すことが明らかに可能である。ただし、ここでは、仮定的B₀界に寄与するために使用されるあらゆるセグメントが、数万アンペアを生成することが可能な電圧源を必要とするであろう。ここでも、B₀界のために最低4つのループのアセンブリを仮定し、さらに、ワトキンズらの構造の各セグメント化されたループが少なくとも4つのセグメントからなると仮定すると、この構造がそれの他の磁界パターンとともにB₀界を同時に発生した場合、極めて高い電流の16個の電源が必要とされよう。その極めて実際的でない要件以上に、B₀界に寄与する上記少なくとも16個のセグメントのそれぞれに関連付けられた極めて高い供給及び復帰電流が、エネルギーの浪費につながり得て、さらにスキャナのイメージングボリューム内の磁界を著しくひずませる可能性があり得る。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0011】

【特許文献1】米国仮特許出願第61/574,823号

【特許文献2】国際出願第PCT/US2012/050462号

【特許文献3】米国特許第6,492,817号

【特許文献4】米国特許第6,933,724号

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

極めて高い電流の複数の電圧源を必要とせずに又は上述の他の問題に対処する必要なしに、合計された電流構成を介して1つ又は複数の他の磁界パターンとともにB₀界を確立することが可能なシステム及び方法を提供することが、本開示の目的である。

【課題を解決するための手段】

【0013】

この目的は、本開示に従って、厚い断面積をもつ伝導ループ、及び極めて高い電流を発生することが可能な単一の電圧源を伴う実施形態を通して達成される。ループの逆並列セグメントは互いに極めて近接して持ってこられ、これは、ループが1つ又は複数のロケーションにおいて効果的に「締め付けられ」、逆並列セグメントの各ペアがスキャナのイメージングボリューム内でほぼ0の磁界に寄与することを意味する。このループにおける不對セグメントは、均一なB₀界を集合的に形成するように整形される。電圧源は、次いで、この厚いループ内の電流の再分配が得られることにより、そのB₀界に加えて、必要とされる傾斜界及び/又はシミング界をそれが同時に確立するように、電流をこの厚いループの1つのポイントから別のループに短絡する。

30

【0014】

単一の厚いループを用いたB₀界及び他の磁界パターンの同時確立のための開示されるシステム及び方法のさらにより良い理解が、以下の図面を参照することによって得られよう

40

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】図1は、B₀界、x傾斜界、y傾斜界、及びz傾斜界を発生することが可能な単一の厚いループであって、電流シャントが取り付けられた、単一の厚いループを太線として示す概略回路図である。

【図2】図2は、図1の単一の厚いループ内の円形構造のいずれか1つに関連付けられ得る実際の電流パターンを示す概略回路図である。

【図3】図3は、図1によって表される概略回路図実施形態がMRIスキャナにおいて実際にどのように見え得るかを示し、図3Aは、物理的な実施形態への変換に備えるために

50

、図1の概略回路図になされた変更を示し、図3Bは、図1の実際の物理的実施形態がどのように現れるかを示し、図3Cは、図3Bの物理的実施形態の環状構造および管状構造がどのように互いに接続されているかを示し、図3Dは、図3Bの物理的実施形態の管状構造内での入れ子式の使用を図示する。

【図4】図4は、共有電流構成を介してB₀界及び他の磁界パターンをも同時に生成する図1の代替実施形態を提示する。

【図5】図5もまた、共有電流構成を介してB₀界及び他の磁界パターンをも同時に生成する図1の代替実施形態を提示する。

【図6A】図6Aは、z傾斜界を形成するために単一の薄いループが使用され得て、取り付けられた電流シャントにより、この単一の薄いループがx傾斜界及びy傾斜界をも確立することが可能になる、図1に類似する構造を示す。

【図6B】図6Bは、図6Aの構造の音響振動がどのように低減され得るかを示す。

【図6C】図6Cもまた、図6Aの構造の音響振動がどのように低減され得るかを示す。

【発明を実施するための形態】

【0016】

図1は、極めて高い電流 I_{polarizing} を生成することが可能な単一の電圧源 V_{HIGH I} から電力を受け取る、太い黒線によって表される、単一の厚い伝導ループ 100 を示す概略回路図である。電圧源 V_{HIGH I} に取り付けられることが通常は予想されるであろう逆並列電流に加えて逆並列電流のいくつかのセグメント 110 が対合されるように、厚いループ 100 は曲げられている。そのような各セグメント対は、イメージングのために指定されたスキャナのボリウム中でほぼ 0 に等しい合成磁界を有するものと理解され、それは、例えば、所与のセグメント対が、セグメントを互いに極めて近くに置くこと、一方のセグメントを他方のセグメント内にテレスコーピングすること、又は 2 つのセグメントを互いに交互絡合することを通して達成され得る。絶縁及び/又はエアギャップは、対の中のセグメントが、互いに直接的な物理的接触を生じること、又は互いに直接的に電氣的に伝導することを防止する。4つの円形構造(部分ループ)を形成する、100の非対セグメントは、それらの円形構造が適切にサイズ決定され、配置されると、電流 I_{polarizing} をもつ B₀ 界を発生する。3つの電流シャント 20 が 100 の 4つの円形構造の各々に接続される。各電流シャント 20 は電圧源 V から電力を受け取り、電流シャント 20 の適切な活性化により、100 によって発生された B₀ 界に x 傾斜界、y 傾斜界、及び/又は z 傾斜界が加えられるように厚いループ 100 中で電流が再分配される。シャントは、それらが互いに視覚的に区別されるのを助けるために、本願図面全体にわたって実線と破線の両方で描かれている。

【0017】

図2は、図1の厚いループ 100 内の円形構造のいずれかの 1 つに関連付けられ得る実際の電流パターンを示す概略回路図である。図2に示された軸に一致して、図2の円形構造は、x-y 平面に対して平行であり、z 軸を中心とするものであると理解される。シャント A 40 は y 軸上のポイント 42 から y 軸上のポイント 44 に電流を伝え、シャント B 60 は x 軸上のポイント 62 から x 軸上のポイント 64 に電流を伝え、シャント C 80 は、図2中の垂直セグメント対の一方のセグメント 110 上のポイント 82 から、垂直セグメント対の他方のセグメント 110 上のポイント 84 に電流を伝える。当業者は、図2に示される電圧源によって発生された電流、及び が、スキャナのイメージングボリウム内の x 傾斜界、y 傾斜界、及び z 傾斜界にそれぞれ寄与し得ることを認識するであろう。当業者はさらに、図2に示された電流、及び を達成するために、図2の電圧源によって生成される必要のある電流及び電圧について容易に解くために、キルヒホッフの接合法則及びループ法則が使用され得ることを諒解するであろう。電圧源から発する電流は、図2に直接示され、シャント電圧は以下の通りである：

$$\begin{aligned}
 V_A &= (2) R + 2 (I_{polarizing} +) R_q \\
 V_B &= (2) R_B + 2 (- I_{polarizing} - +) R_q \\
 V_C &= (- +) R_C + 4 (I_{polarizing} +) R_q、
 \end{aligned}$$

10

20

30

40

50

ただし、 R_q は円形構造の各 $1/4$ の抵抗であり、 R_A はシャント A に関連する総抵抗であり、 R_B はシャント B に関連する総抵抗であり、 R_C はシャント C に関連する総抵抗である。

【0018】

図 3 は、図 1 の概略実施形態が MRI スキャナにおいて実際に物理的にどのように見え得るかを示す。図 3 A は、図 3 B の予備図であり、削除されている図 1 の垂直セグメント対を示す。図 1 の垂直セグメント対は、 B_0 界を実際に発生する 100 の非対セグメントから対合されたセグメント 110 をよりはっきり視覚的に分離することによって本実施形態がより良く理解されるのを助けるが、それらは本実施形態の動作のために必要ではなく、実際は、それらの電流はエネルギーの浪費を表す可能性があり得る。図 3 B は、各円形構造が図 2 の円形構造と同じ配向を有する、図 1 の概略回路図の実際の物理的顯示を示す。当業者は、図 3 B の最初の 2 つの円形構造及び最後の 2 つの円形構造にそれぞれ関連する対抗電流が z 傾斜界の生成に一致し、一方、中間の 2 つの部分ループの並列電流及び中間の 2 つの部分ループの並列電流が x 傾斜界及び y 傾斜界のそれぞれの生成に一致することを認識するであろう。

10

【0019】

図 3 B に関するいくつかの実際的な注記がここで行われ得る。第 1 に、各シャント及び各シャントは、 z 軸に直角に進むとき、2 つの分岐に分かれることがわかる。この分岐に関連する正確な構成は、スキャナによって発生される x 及び y 傾斜磁界パターンを保存するように示され得る。当業者は、本開示に関連するシャントは、スキャナのイメージングボリューム内で所望される磁界パターンをひずませないように概して構築されていることを確認できるであろう。第 2 に、図 3 B の厚いループは、その内の渦電流の形成を防止するスロットを含んでいなければならないことがある。これらのスロットは、ループから生じる磁界パターンの全体的な精度に影響を及ぼさないように設計されるべきである。第 3 に、この厚いループのインダクタンスを克服するためにシャント中に電流を駆動する電圧源が使用され得、このようにして、この厚いループによって確立される磁界が、典型的には MRI スキャニングのために必要とされるときのように迅速に（すなわち、約 $1/2$ ミリ秒中に）変更されることが可能になることがわかる。第 4 に、関連する電圧源 V_{HI} G_H I は、この厚いループに関連する極めて高い電流及び極めて低い抵抗を特に取り扱うように構築される必要がある可能性があり得る。これは、例えば、並列に互いに配線された整流器コントローラユニットのスタックの使用によって、及び絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT)、サイリスタ、又は他の半導体技術を採用することによって達成され得る。

20

30

【0020】

図 3 C は、それにより図 3 B の円形構造が図 3 B の管状構造によって互いに接続される手段を示し、それはまとめて図 1 の水平セグメント対に対応する。明らかに、管状構造と図 3 B の各円形構造との間には、これらの構造が構築される導体の厚みのみのために、図 3 A によって示された垂直セグメント対が削除された場合でも、短い逆電流セグメント対が存在することになる。

【0021】

図 3 D は、図 1 の水平セグメント対に対応する電流がスキャナのイメージングボリューム内で合計でほぼ 0 になることを保証するのを助けるためのテレスコピングの使用を示す。当業者なら、可能な最高度の電流消去を達成するための方法に気づいているはずであり、この電流消去の精度は、スキャナのイメージングボリューム内で許容される対応する磁界汚染の最大しきい値に関して指定され得る（例えば、選択肢の中でも、 B_0 界の大きさに関して、1 パートパーミリオン、5 ppm、10 ppm、又は 50 ppm）。

40

【0022】

図 4 A は、シャントが、同じ円形構造内のポイントとは対照的に異なる円形構造間のポイントを接続する、図 1 の実施形態の変形形態を示す。図 4 B は、 B_0 界が、4 つの円形構造とは対照的に 6 つの半円形構造及び 1 つの円形構造によって発生される、図 1 の実施形

50

態の変形形態を示す。

【0023】

図5Aは、2つの別個のシャントが厚いループの同じポイントに接続され得ることを示す図1の実施形態の変形形態である。図5Bは、シャントが厚いループの3つ以上のポイントに接続され得ることを示す変形形態である。図5Cは、厚いループがB₀界及び傾斜界に加えてシミング界を生成することを特に可能にするものと当業者が認識するであろう変形形態である。図5Dは、2つのシャントがノードにおいて交差することができることを示し、図5Eは、2つのシャントが、円、ポリゴン、又はより複雑な構造を介して交差することができることをさらに示唆する。

【0024】

図5Fは、厚いループ又は極めて大きい電流を生成することが可能な電圧源のいずれかを実際に使用せずに、合計された電流構造を用いてB₀界及び他の磁界パターンを達成するための方法を示す図1の実施形態の変形形態である。特に、図1の厚いループ100は、わずか数十アンペア程度の電流を搬送する薄いループと置き換えられる。さらに、図1の場合のように、硬い円形構造をそれぞれ形成するループの不对セグメントの代わりに、各不对セグメントは、何回も並列に巻かれ得る極めて長い、フレキシブルなセグメントである。図5Fの上部の3つの薄い円形構造は、1つのそのような長い、フレキシブルなセグメントの個々の巻線を表すと仮定される。巻かれた長い、フレキシブルな各セグメントに関連するアンペア回数の総数は、図5Fの不对セグメントが、図1に関連するB₀界程度のB₀界を発生するのに十分大きい。さらに、各巻線と、図5Fの下部の近くの垂直セグメント対とに取り付けられたシャントは、x傾斜界、y傾斜界、及び/又はz傾斜界がそのB₀界と同時に発生されることを可能にする。

【0025】

図6Aは、図5Fのように、極めて大きい電流を搬送しない薄いループ100'を使用する図1の変形形態である。ただし、図6Aの構造は、図5Fの構造が含んでいるように長い、フレキシブルなセグメント及び巻線を含んでおらず、したがって、図6Aの回路は、B₀界を発生するようにはまったく意図されていない。代わりに、図6Aは、図1の類似物を示すように意図されており、ここでは、主要な薄いループ100'が非B₀電磁界パターンを確立し、その初期非B₀電磁界パターンに他の磁界パターンをアドオンするために、主要な薄いループ100'に取り付けられたシャント20が使用される。図6Aの特定のケースにおいて、主要な薄いループ100'はz傾斜界を発生し得、そのループ100'に接続されたシャント20は、次いで、そのz傾斜界にx傾斜界及び/又はy傾斜界を加えるはずである。

【0026】

当業者によく知られているように、極めて強い磁界にさらされ、また時間とともに変化している電流を含んでいる構造は、概してローレンツ力から振動し、それにより、音響雑音を発生する。変化している電流をもつ厚いループ100のセグメントは、概して、厚いループ100の他のセグメントから発する界に関連するローレンツ力からの影響を受けないことが予想され得る。一方、B₀界発生構造の近くに置かれた薄いループ100'は、明らかにローレンツ力の影響を受けやすいことがある。その問題を緩和するための1つの方法が図6Bを通じて示されている。図6Bにおいて、薄いループ100'とB₀界を発生する構造400の両方が円形断面を有し、B₀界を発生する構造400の一部において対称的に形成されている中空円形トンネル402中に、薄いループ100'の一部が対称的に配置されている。同様に、図6Cでは、薄いループ100'とB₀界を発生する構造500の両方がこの場合も円形断面を有するが、今度は、薄いループ100'の一部において対称的に形成されている中空円形トンネル502中に、B₀界を発生する構造500の一部が対称的に配置されている。当業者なら、図6B及び図6Cに示された構成の対称性により、B₀界を発生する構造の内部に置かれるか又はその一部を包囲するようにされる薄いループ100'の一部の音響振動は、B₀界を発生する構造に100'のその一部が単に隣

10

20

30

40

50

接するままにされた場合に100'のその一部が受けるであろう振動に対して、低減される可能性があり得ることを理解するであろう。振動のそのような低減は、同心にされた薄いループ100'の一部と B_0 界を発生する構造の一部とが両方とも比較的大きい曲率半径を有する場合、より著しくなることが予想されるであろう。

【0027】

当業者は、上記の図を通じて提示されたもの以外に、本開示に関連する多くの他の変形形態があることを理解するであろう。いくつかの実施形態では、厚いループが分岐し再結合するようにされるか、あるいは複数の厚いループと一緒に配置され得るが、電流の全体的な構造は、図1の実施形態について説明されたものと依然として等価であり得る。厚いループは、いくつかの実施形態では、スキャナに必要とされる B_0 界の一部のみを発生するが、場合によっては図1に示されているように現れ得る。各電流シャントは、いくつかの実施形態では、その電圧源に加えて厚いループ内の必要とされる電流の分配を達成するのに助けるために使用され得る何らかの可変抵抗を持ち得る。各電流シャントは、いくつかの実施形態では、厚いループの複数のポイントからの電流、厚いループの複数のポイントへの復帰電流、又は両方をピックアップし得る。上記で論じられたいかなる所与の電圧源も、いくつかの実施形態では、例えば、一つの厚いループスキャナの厚いループに電力供給するために使用される高電流電圧源の場合に当てはまる可能性があり得るように、直列及び/又は並列に接続された電圧源のグループと交換され得る。本開示は、明らかに、磁界パターンを発生するMRIスキャナ以外のシステムにおいて使用され得る。核磁気共鳴スペクトロスコピー、電子常磁性共鳴スペクトロスコピー、及び電子常磁性共鳴イメージングは、本開示が適用され得る非MRI方法の3つの例である。

10

20

【産業上の利用可能性】

【0028】

本開示のシステム及び方法が今や開示されたので、当業者は、以下の段落において説明される利点の一部又は全部が可能にされ得ることを理解するであろう。以下の段落では、図1に描かれた回路の物理的実施形態は「厚いループスキャナ」と呼ばれる。

【0029】

厚いループスキャナの第1の利点は、MRIにおいて B_0 界磁界パターンの精度が特に重要であるとすれば、厚いループスキャナの部分ループが、電氣的にその B_0 界を生成するだけの抵抗性MRIスキャナにおける典型的な B_0 界生成巻線の位置、直径、及び厚みに等しいか又はほぼ等しい位置、直径、及び厚みを有するように設計されることがあり得るといことからわかるであろう。これは、シャントの経路が、図3Bの場合のように、厚いループによって囲まれたボリュウムの外部にあるように設定されると仮定すると、広さの観点から、厚いループスキャナは、 B_0 界及び B_1 界発生構造のみを含んでいるMRIスキャナと等価になることを意味する。無線周波数コイルセットのサイズは、厚いループスキャナ内で解放される空間により、通常よりも大きくされることが可能であり得る。大幅に増加した広さの感覚は、病気検査を一般集団にとってより快いものにする可能性があり得、肥満した個人のイメージング、閉所恐怖症をもつ個人のイメージング、獣医学イメージング、及び介入性又は外科的手技中のイメージングのための機会をも増加させるであろう。

30

40

【0030】

厚いループスキャナの第2の有利な特徴は、比較的低い予想製造コストである。 B_1 界発生構造以外のただ1つの有意な磁界発生構造がスキャナのために製造される必要があり得る。さらに、厚いループは、おそらく成形品からアSEMBルされるであろう、したがって、ワイヤを慎重に繰り返し巻くことから形成される構造と比較して、作成するのによりコスト効果的であろう。成形構造はまた、巻かれた構造よりも輸送の機械的応力から生じる誤差を受けにくく、その理由で、例えば、発展途上国への寄付のために、多数の巻線をもつスキャナの場合に当てはまり得るよりも、厚いループスキャナを分解し、それを他の場所で再アSEMBルすることがより経済的であり得る。電流シャントは、厚いループスキャナの厚いループとともに製造され、その厚いループに取り付けられなければならないこと

50

は、真実である；しかしながら、厚いループ自体のように、電流シャントは比較的単純な構造である。

【0031】

厚いループスキャナの第3の有利な特徴は、比較的静かな動作を提供するその能力である。標準のMRIでは、様々な構造がしばしば、密嵌している同心シリンダーの形態で互いの内に配置される；しかしながら、上記で説明されたように、厚いループスキャナは、比較的大量の自由空間を有することが予想される。この増加した空間の一部は、電流シャントの周りの細長い真空チューブの配置に充てられ得、それにより、それらの電流の値が変化するときシャントに作用するローレンツ力から生じる雑音伝送が著しく低減され得る。厚いループによって囲まれたボリュームの外にシャントが位置することが示される図3Bに示された配置をシャントが有することになった場合、及びシャントを囲むために使用される真空チューブは、単に、8つのまっすぐな真空チューブ、及び2つの円形真空リングから構成され得る。厚いループはおそらく1,000kg程度の重さになり、したがって、その電流が変化したときに著しく振動する可能性が低くなり得るので、真空チューブは、厚いループ自体のどの部分の周りにも配置される必要はないであろう。

10

【0032】

今やB₀界及び他の磁界パターンの同時確立のための開示されたシステム及び方法を読んで理解したので、当業者は、上記の開示によって可能にされている他の利点、変形形態、及び実施形態を認識するであろう。そのような利点、変形形態、及び実施形態は、添付の特許請求の範囲及びそれらの法的均等物の範囲及び意味の一部であると見なされるべきである。

20

【0033】

上記では特定の実施形態について説明されたが、これらの実施形態は、特定の特徴に関して1つの実施形態しか説明されていない場合でも、本開示の範囲を限定するものではない。本開示において提供される特徴の例は、別段に記載されていない限り、限定的ではなく例示的であるように意図されている。上記の説明は、本開示の利益を有する当業者に明らかであるはずのそのような代替形態、変更形態、及び等価形態を包含するものである。

【0034】

本開示の範囲は、それが本明細書において対処された問題のいずれか又はすべてを緩和するか否かにかかわらず、(明示的にあるいは暗黙的に)本明細書で開示された任意の特徴又は特徴の組合せ、あるいはそれらの任意の一般化を含む。本開示の様々な利点について本明細書で説明されたが、特許請求の範囲によってカバーされる実施形態は、そのような利点の一部、全部を提供するか、又はそのような利点をまったく提供しないことがある。

30

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

イメージングボリューム内での、均一B₀界の一部又は全部の生成のための、ならびに必要とされる傾斜界及び/又はシミング界の同時生成のためのデバイスであって、前記デバイスは、

40

主伝導ループと、

分極電流を発生することが可能な単一の電圧源、又は、分極電流を発生することが可能な単一の実効電圧源と、

複数の電流シャントと、

を備え、

前記分極電流を発生することが可能な単一の実効電圧源が、直列に及び/又は並列に接続された電圧源のグループからなり、更には、

50

分極電流を発生することが可能な前記単一の電圧源又は単一の実効電圧源が、前記主伝導ループと直列に接続され、
前記主伝導ループが、
1つ又は複数の消去セグメント対と、
2つ以上の寄与セグメントと、
を含むように整形され、
各前記消去セグメント対の2つの消去セグメントが、
電流が逆平行であるように、互いに極めて近接して持ってこられた前記主伝導ループのセグメントであり、
共に前記デバイスの前記イメージングボリューム内でほぼ0の磁界に寄与し、
各前記寄与セグメントが、
前記主伝導ループの前記消去セグメント以外のセグメントである不對セグメントであり、
前記寄与セグメントが、複数の不完全なループにグループ化され、
各個々の前記不完全なループが、
1つ又は複数の前記寄与セグメントからなり、
その円周に1つ又は複数の小さいギャップを有する完全なループと等価であり、
共通の軸を中心とするものであり、
前記複数の不完全なループの全体が、
前記デバイスの前記イメージングボリューム内で前記均一 B_0 界の一部又は全部を集合的に形成するように整形され、
各前記消去セグメント対の前記2つの消去セグメントが、
介在する少なくとも1つの寄与セグメントによって、前記主伝導ループの全長に沿って離れて配置され、
前記主伝導ループの両端部のそれぞれに両方とも配置されるものではなく、
各前記電流シャントが、1つ又は複数のシャント導体セグメントと、前記1つ又は複数のシャント導体セグメント内に挿入された少なくとも1つのシャント電圧源とを備え、
前記1つ又は複数のシャント導体セグメントが、前記主伝導ループとは別個であり、
前記少なくとも1つのシャント電圧源が、分極電流を発生することが可能な前記単一の電圧源又は単一の実効電圧源とは別個であり物理的に分離しており、
各前記電流シャントが、電流を、前記主伝導ループの1つ又は複数のポイントから、前記主伝導ループの1つ又は複数の他のポイントに短絡するように構成され、
各前記不完全なループについて、
前記不完全なループの前記円周における1つの前記小さいギャップの両側が、シャント導体セグメントの終端に接続され、
前記複数の不完全なループのうちの少なくとも2つの不完全なループのそれぞれについて、
前記不完全なループの前記円周上の4つの位置が、シャント導体セグメントの終端に接続され、前記4つの位置が、前記共通の軸によって定義される座標システム内でアジマス方向に90°の間隔を有し、
前記複数の不完全なループのうちの前記少なくとも2つのすべてについて、
前記4つの位置のそれぞれのアジマスが同一であり、
それにより、前記デバイスは、
分極電流を発生することが可能な前記単一の電圧源又は単一の実効電圧源からの前記電流を用いて、磁気共鳴イメージング又はスペクトロスコピーのための、あるいは電子常磁性共鳴イメージング又はスペクトロスコピーのための前記均一 B_0 界の一部又は全部を発生すること、
ならびに、
前記シャント電圧源を介して前記主伝導ループ内で電流を再分配することを通して前記均一 B_0 界の一部又は全部と同時に前記必要とされる傾斜界及びノ又はシミング界を確立すること

10

20

30

40

50

の両方が可能になる、デバイス。

【請求項 2】

各前記不完全なループが、正確に 1 つの前記寄与セグメントからなる、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 3】

前記複数の不完全なループのうち 1 つを除く全てが、1 つより多い前記寄与セグメントからなる、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 4】

各個々の前記不完全なループが、その下に、垂直な前記消去セグメント対又は前記消去セグメント対の垂直部分のいずれかを有する請求項 1 に記載のデバイス。

10

【請求項 5】

前記共通の軸によって定義される前記座標システム内でアジマス方向に 90° の間隔を有する 4 つの位置が前記シャント導体セグメントの終端に接続される、各前記不完全なループについて、

第 1 の電流シャントが、前記 4 つの位置のうちの第 1 の位置と第 2 の位置との間に結合され、前記第 1 の位置と前記第 2 の位置とが、前記不完全なループ上で互いに直径の反対側にあり、更には、

第 2 の電流シャントが、前記 4 つの位置のうちの第 3 の位置と第 4 の位置との間に結合され、前記第 3 の位置と前記第 4 の位置とが、前記不完全なループ上で互いに直径の反対側にあり、それにより、前記第 3 の位置及び前記第 4 の位置上にあるラインが、前記第 1 の位置及び前記第 2 の位置上にあるラインに対して 90° 回転した状態にある、請求項 1 に記載のデバイス。

20

【請求項 6】

前記第 1 の位置と前記第 2 の位置との中間の前記第 1 の電流シャントの一部が、2 つの分岐に分けられ、

前記第 3 の位置と前記第 4 の位置との中間の前記第 2 の電流シャントの一部も、2 つの分岐に分けられる、

請求項 5 に記載のデバイス。

【請求項 7】

各前記不完全なループが、

円形に形成され、

及び、前記共通の軸に垂直な面に位置する、

請求項 6 に記載のデバイス。

30

【請求項 8】

前記複数の電流シャントの少なくとも 1 つが可変抵抗を持つ、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 9】

前記複数の電流シャントの少なくとも一つが真空チューブ内に置かれる、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 10】

前記複数の電流シャントが、前記不完全なループの隣接するペアのそれぞれが接続ボリュームと接続された場合に形成される通路によって囲まれるボリュームの外に位置し、前記接続ボリュームのそれぞれは、前記共通の軸に中心付けられたトンネル状の構造であり、前記接続ボリューム毎に、二つの端面、一つの内面、及び、一つの外面を有し、前記二つの端面は、前記接続ボリュームと接続された二つの隣接する前記不完全なループの向き合う側の面のそれぞれに、正確に一致及び隣接し、前記内面及び前記外面はそれぞれ、最小限の面積を有する請求項 1 に記載のデバイス。

40

【請求項 11】

前記分極電流を発生することが可能な単一の実効電圧源が、並列に配線され絶縁ゲートバイポーラトランジスタを採用する複数の整流器コントローラユニットから形成された、請

50

求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 2】

前記分極電流を発生することが可能な単一の実効電圧源が、並列に配線されサイリスタを採用する複数の整流器コントローラユニットから形成された、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 3】

前記主伝導ループの前記全長に沿って、任意の 2 つの隣接する寄与セグメントが、介在する 2 つあるいは 3 つの消去セグメント対に属する消去セグメントによって離れて配置される、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 4】

前記主伝導ループの前記全長に沿って、任意の 2 つの隣接する寄与セグメントが、介在する 1 つの単一の消去セグメントによって離れて配置される、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 5】

前記寄与セグメントの幾何学的中心が、すべて前記共通の軸上に整列する、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 6】

前記寄与セグメントの幾何学的中心が、すべて前記共通の軸上に整列するものではない、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 7】

前記消去セグメント対の前記 2 つの消去セグメントの磁界消去が、前記消去セグメントの一方の、他方の消去セグメント内のテレスコーピングを伴う、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 8】

前記消去セグメント対の前記 2 つの消去セグメントの磁界消去が、前記 2 つの消去セグメントの擦り合わせを伴う、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 1 9】

すべての前記消去セグメント対に関連する電流消去の度合いが、前記デバイスの前記イメージングボリューム内の磁界汚染の指定された最大しきい値を超えない磁界汚染のレベルに対応する、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 2 0】

磁界汚染の前記指定された最大しきい値が、前記均一 B_0 界の大きさに関して 1 パートパーミリオンと 50 パートパーミリオンとの間の値である、請求項 1 9 に記載のデバイス。

【請求項 2 1】

前記主伝導ループが、成形品からアSEMBルされる、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 2 2】

スキャナのイメージングボリューム内で、均一 B_0 界の一部又は全部を生成するための、ならびに必要とされる傾斜界及び / 又はシミング界を同時に生成するための方法であって、前記方法は、

主伝導ループと直列に、分極電流を発生することが可能である、単一の電圧源、あるいは直列に及び / 又は並列に接続された電圧源のグループを接続するステップと、

1 つ又は複数の消去セグメント対と、2 つ以上の寄与セグメントと、を含むように前記主伝導ループを整形するステップであって、

各前記消去セグメント対の 2 つの消去セグメントが、

電流が逆平行であるように、互いに極めて近接して持ってこられたか、又は効果的に互いに締め付けられた、前記主伝導ループのセグメントであり、

共に前記スキャナの前記イメージングボリューム内でほぼ 0 の磁界に寄与し、

各前記寄与セグメントが、

前記主伝導ループの前記消去セグメント以外のセグメントである不對セグメントであり、

前記寄与セグメントが前記スキャナの前記イメージングボリューム内で前記均一 B_0 界の一部又は全部を集合的に形成するように整形される

10

20

30

40

50

前記主伝導ループを整形するステップと、

前記主伝導ループに、複数のシャント電圧源を取り付けるステップであって、各前記シャント電圧源が、電流を、前記主伝導ループの1つ又は複数のポイントから、前記主伝導ループの1つ又は複数の他のポイントに短絡するように構成される、複数のシャント電圧源を取り付けるステップと、

を備え、それにより、前記方法は：

分極電流を発生することが可能な前記単一の電圧源又は分極電流を発生することが可能な前記電圧源の前記グループからの前記電流を用いて、磁気共鳴イメージング又はスペクトロスコピーのための、あるいは電子常磁性共鳴イメージング又はスペクトロスコピーのための前記均一B₀界の一部又は全部を発生すること、

10

及び、

前記シャント電圧源を介して前記主伝導ループ内で電流を再分配することを通して前記均一B₀界の一部又は全部と同時に前記必要とされる傾斜界及び/又はシミング界を確立すること

の両方が可能になる、方法。

【請求項23】

前記主伝導ループの1つ又は複数のポイントから、前記主伝導ループの1つ又は複数の他のポイントへの電流の前記短絡が、可変抵抗を伴う、請求項22に記載の方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

20

【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更

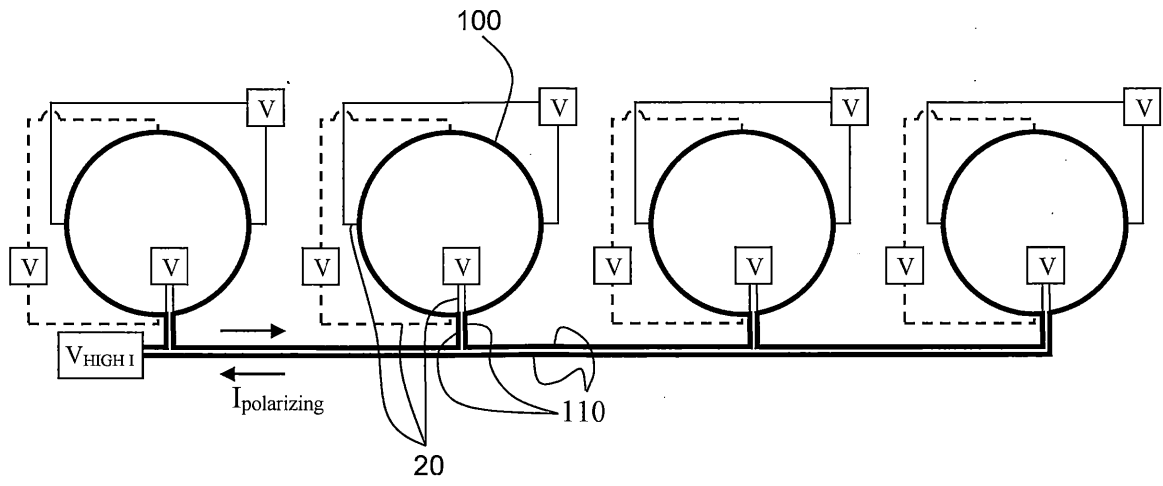
【補正の内容】

30

40

50

【 図 1 】



10

20

Fig. 1

30

40

50

【 図 2 】

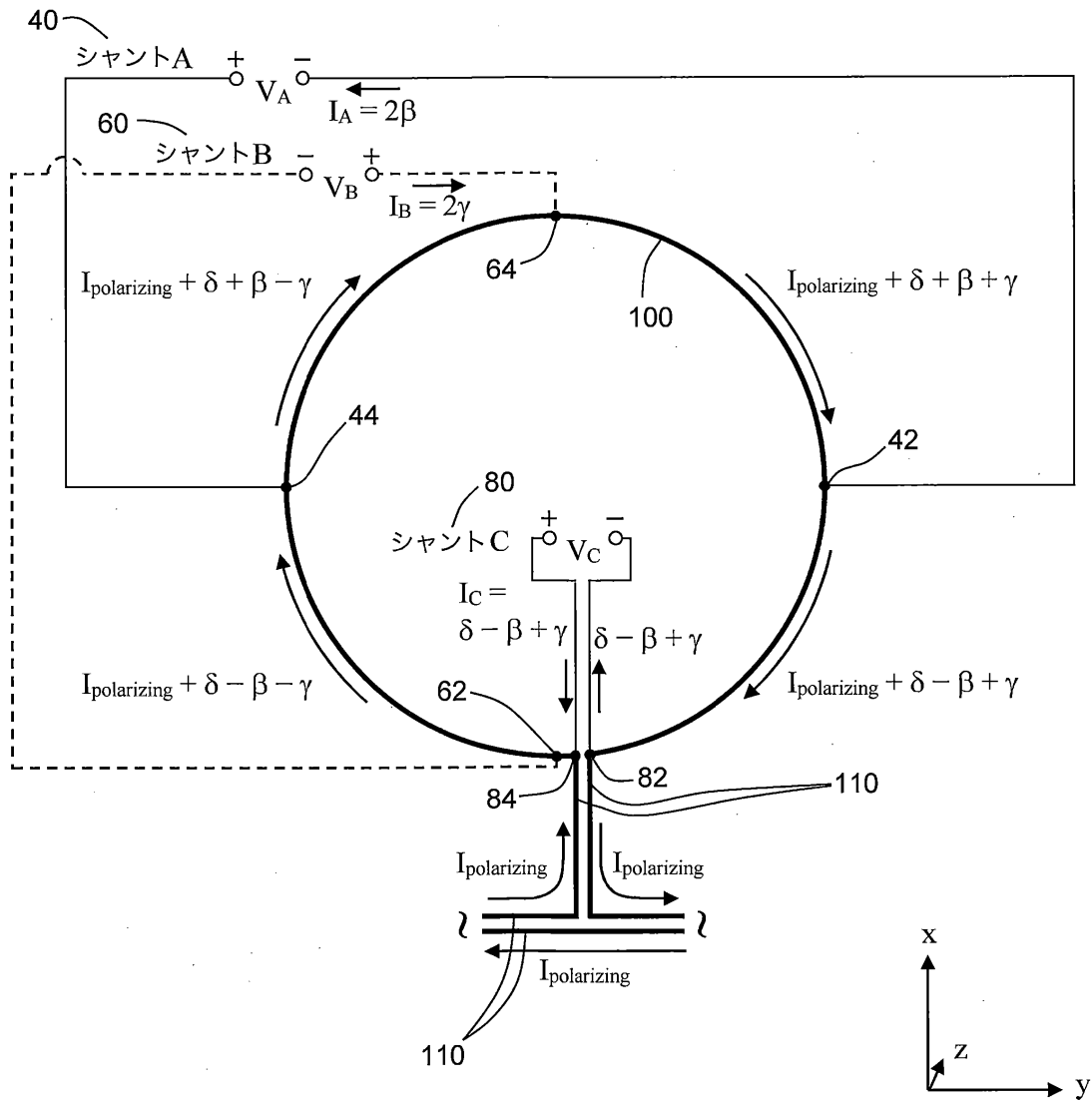


Fig. 2

【 図 3 】

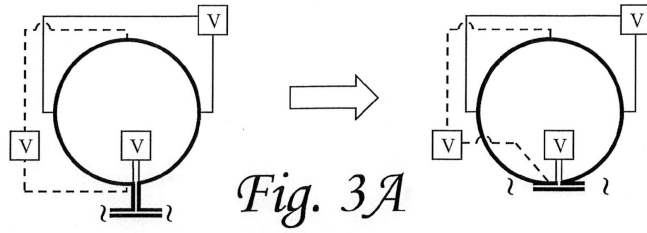


Fig. 3A

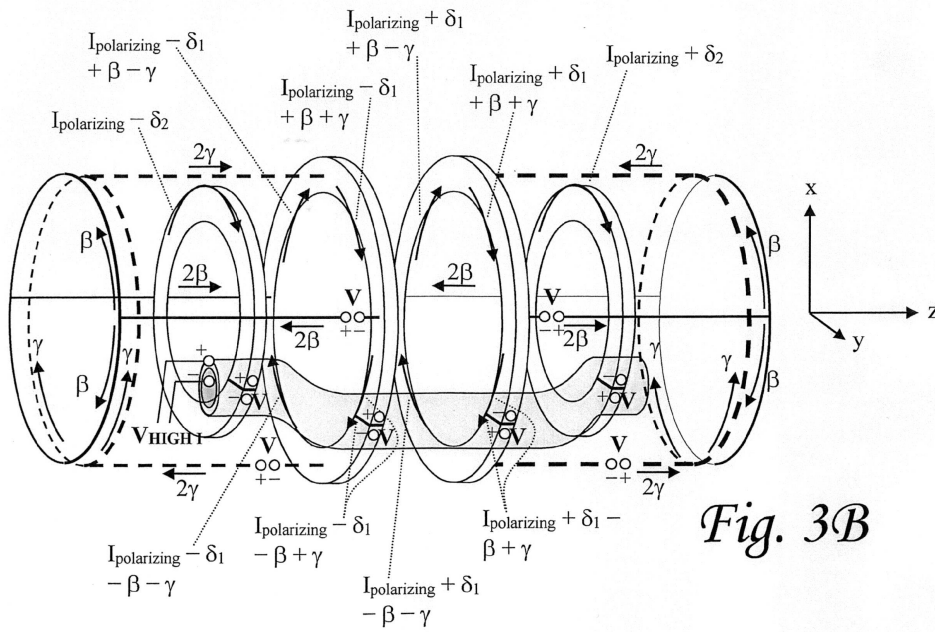


Fig. 3B

(図 3 B,3C,3Dの導体内の黒い実線は絶縁を示す)

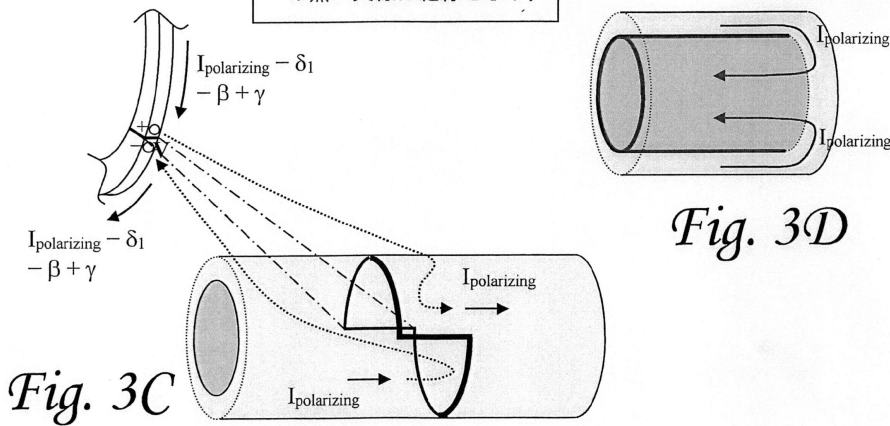


Fig. 3C

Fig. 3D

10

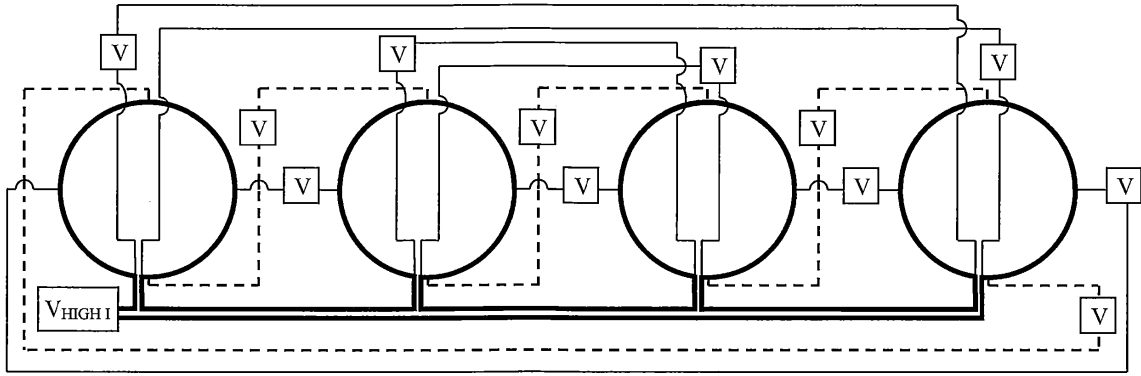
20

30

40

50

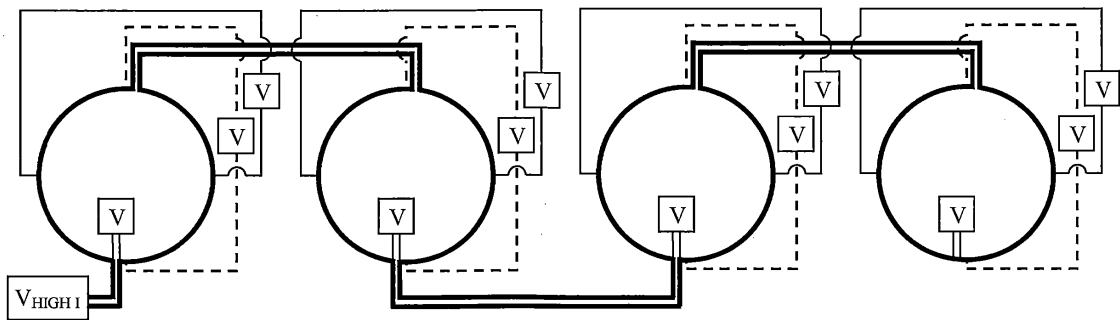
【 図 4 】



10

Fig. 4A

20



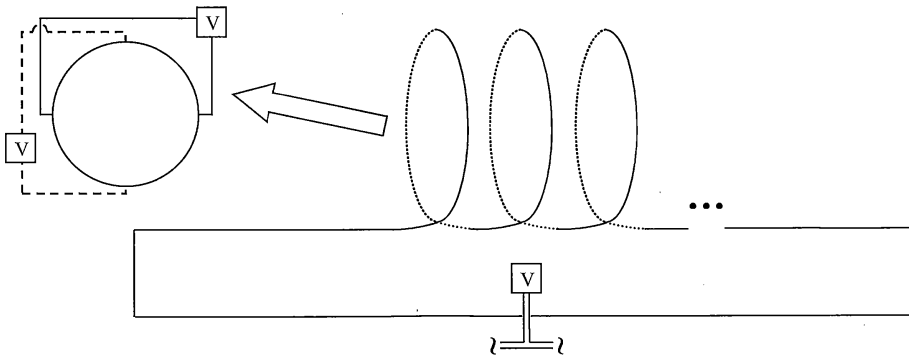
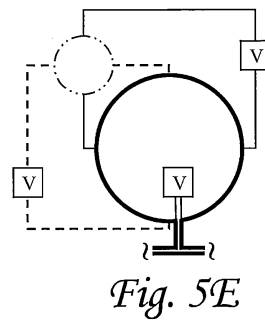
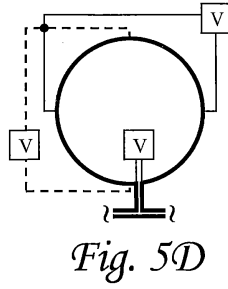
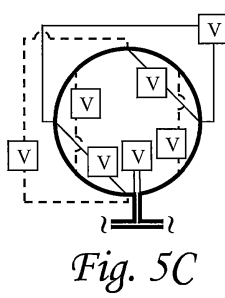
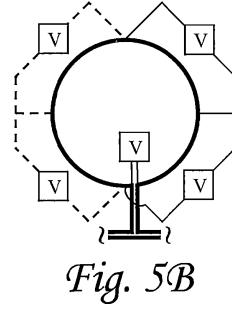
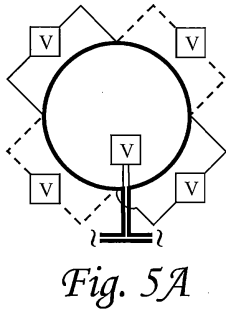
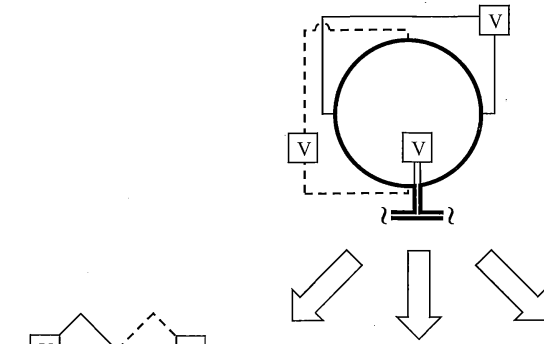
30

Fig. 4B

40

50

【 図 5 】



10

20

30

40

50

Fig. 5A

Fig. 5B

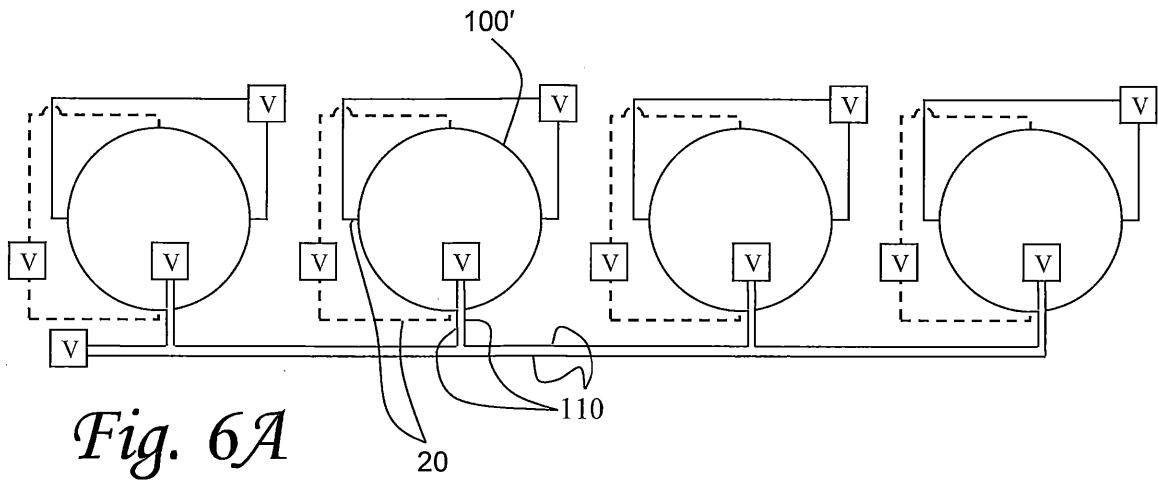
Fig. 5C

Fig. 5D

Fig. 5E

Fig. 5F

【 図 6 A 】



10

20

30

40

50

【 6 B 】

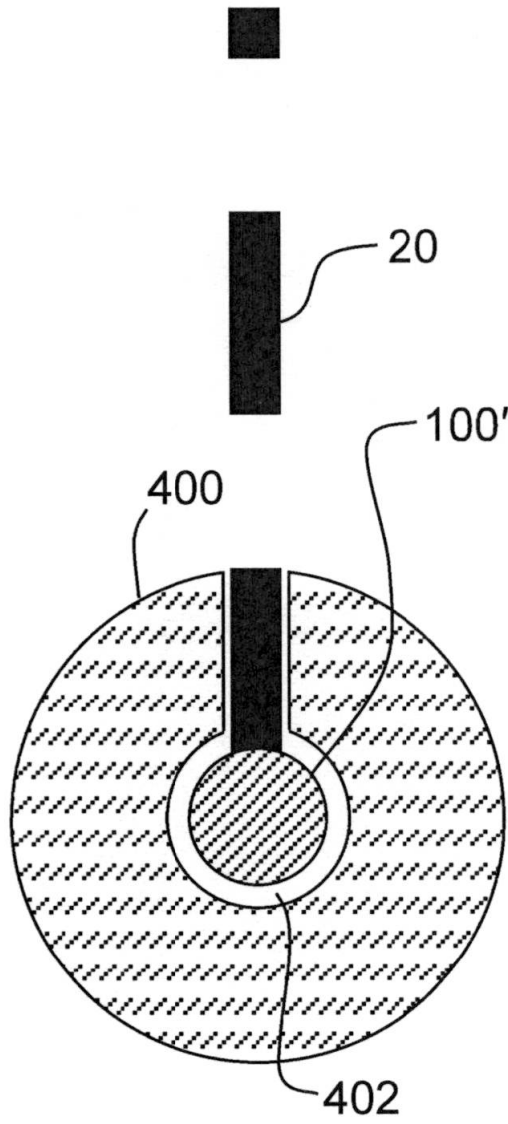


Fig. 6B

10

20

30

40

50

【 6 C 】

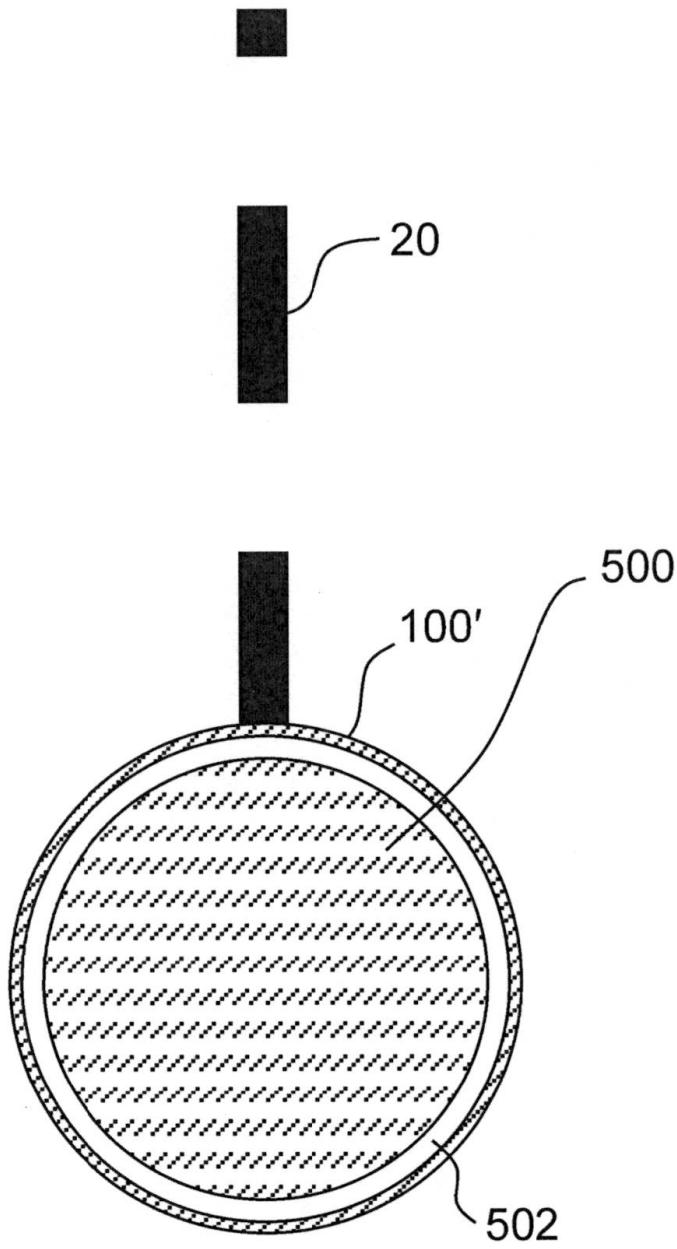


Fig. 6C

10

20

30

40

50